

2ПС104Г, Транзисторная матрица

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

2ПС104Г матрицы полупроводниковой:

2ПС104Г — транзисторная матрица (артикулярное наименование по ГОСТ) транзисторы кремний эпитаксиальнопланарные ионнолегированные полевые с затвором PN перехода каналом P спаренные, назначение для применения в входящих каскадах дифференциальных мало шумящих усилителей НЧ и постоянного тока с большим сопротивлением на входе. Сборки биполярные полевые полупроводниковые используются в РЭА в широком спектре использования. Матрицы выполнены металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Модель прибора, знак завода и дата выпуска наносится на металлической части корпуса. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует 2) техническим условиям аА0.339.033ТУ.

Ссылки на технические материалы

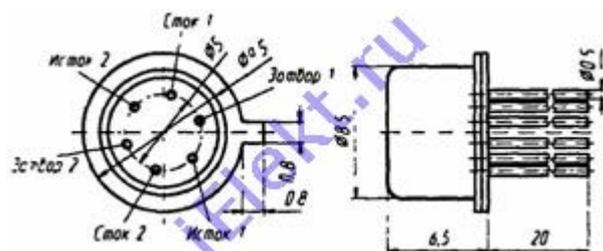
ссылки на дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	габариты	параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Расположения выводов схематическое, назначение выводов, габаритные размеры, маркировка



Вес не превышает 2г.

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

основные электро параметры:

Наименование параметра (режим замера), единица замера	Допуск	
	больше	меньше
Крутизна характеристики отдельного транзистора в паре, mA/V при $U_{си}=10V$, $U_{зи}=0$: T=+25°C: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б	0,35	
типичное значение	0,8	
2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е	0,65	
типичное значение	1	
2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д	1	
типичное значение	1,7	
T=-60°C: 2ПС104А, 2ПС104Б	0,35	
2ПС104В, 2ПС104Е	0,65	
2ПС104Г, 2ПС104Д	1	
T=-45°C: КПС104А, КПС104Б	0,35	
КПС104В, КПС104Е	0,65	
КПС104Г, КПС104Д	1	
T=+125°C: 2ПС104А, 2ПС104Б	0,25	
2ПС104В, 2ПС104Е	0,3	
2ПС104Г, 2ПС104Д	0,5	
T=+85°C: КПС104А, КПС104Б	0,25	
КПС104В, КПС104Е	0,3	
КПС104Г, КПС104Д	0,5	
Шумовой вольтаж отдельного транзистора в полосе частот $f=0,1...10Hz$, μV , при $U_{си}=10V$, $R_n=30k\Omega$, $I_c=0,18mA$ для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, $I_c=0,5mA$ для двух транзисторов 2ПС104В, КПС104В, $I_c=1,5mA$ для двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д: 2ПС104А, КПС104А		0,4
типичное значение		0,35
2ПС104Б, 2ПС104Г, КПС104Б, КПС104Г		1
типичное значение		0,8
2ПС104В, 2ПС104Д, КПС104В, КПС104Д		5
типичное значение		1,5
Разность вольтажей затвор/исток, mV, при $U_{си}=10V$, $I_c=0,18mA$ для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, $I_c=0,5mA$ для двух транзисторов 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е, $I_c=1,5mA$ для двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д: T=+25°C: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б		30
типичное значение		10
2ПС104В, 2ПС104Г, КПС104В, КПС104Г		50
типичное значение		10
2ПС104Е, КПС104Е		20
типичное значение		10
T=+85°C: КПС104А, КПС104Б, КПС104Е		60
КПС104В, КПС104Г, КПС104Д		70

T=+125oC: 2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е		60
2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д		70
Температурный уход разности вольтажа затвор/исток, uV/oC, при Uси=10V, Ic=0,18mA для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, Ic=0,5mA для двух транзисторов 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е, Ic=1,5mA для двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПСЮ4Г, КПС104Д: 2ПС104А, КПС104А		50
типичное значение		20
2ПС104Б, 2ПС104В, 2ПС104Д, КПС104Б, КПС104В, КПС104Д		150
типичное значение		50
2ПС104Г, КПС104Г		100
2ПС104Е, КПС104Е		20
типичное значение		10
Вольтаж отсечки (отрицательное) отдельного транзистора в паре, V, при Uси=10V, Ic=10uA: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б	0,2	1
2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е	0,4	2
2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д	0,8	3
Начальный ампераж стока отдельного транзистора в паре, mA, при Uси=10V, Uзи=0: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б	0,1	0,8
2ПС104В, КПС104В	0,35	1,5
2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д	1,1	3
2ПС104Е, КПС104Е	0,35	3
Ампераж утечки затвора отдельного транзистора в паре, nA, при Uси=0, Uзи=-10V: T=+25oC: 2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е, КПС104А, КПС104Б, КПС104Е		0,3
типичное значение		0,1
2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104В, КПС104Г, КПС104Д		1
типичное значение		0,3
T=+85oC: КПС104А, КПС104Б, КПС104Е, uA		0,15
КПС104В, КПС104Г, КПС104Д, uA		0,15
T=+125oC: 2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е, uA		0,3
2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д, uA		1
Входная емкость отдельного транзистора в паре, pF, Uси=10V, Uзи=0		4,5
Проходная емкость отдельного транзистора, pF, при Uси=10V, Uзи=0		1,5

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.